# 5 Versterkers

Ing. Patrick Van Houtven



# 5-1 instelling voor transistor als versterker

## **Spanningsdelerinstelling**

Meest gebruikte instelling om transistor als versterker in te stellen.

Deze instelling zorgt er voor dat de invloed van  $\beta$  beperkt is op de schakeling.

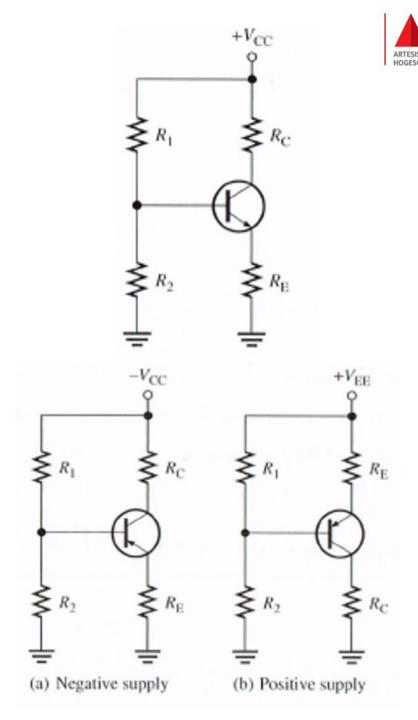
$$U_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times U_{CC}$$

$$U_E = U_B - U_{BE} = U_B - 0.7 V$$

$$I_E = \frac{U_E}{R_E} \approx I_C$$

$$U_C = U_{CC} - I_C R_C$$

$$U_{CE} = U_C - U_E$$

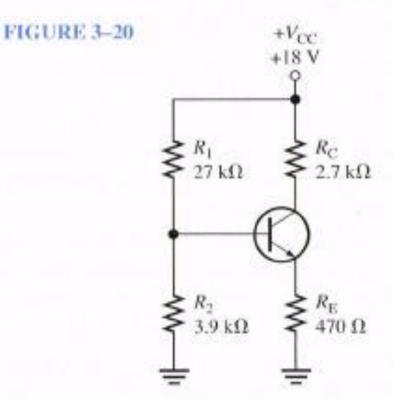


# 5-1 instelling voor transistor als versterker



# EXAMPLE 3-5

Find  $V_B$ ,  $V_E$ ,  $I_E$ ,  $I_C$ , and  $V_{CE}$  for the circuit in Figure 3–20.



**BJTs** 

#### SOLUTION

Begin by finding the base voltage using the voltage-divider rule.

$$V_{\rm B} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) V_{\rm CC} = \left(\frac{3.9 \,\mathrm{k}\Omega}{27 \,\mathrm{k}\Omega + 3.9 \,\mathrm{k}\Omega}\right) 18 \,\mathrm{V} = 2.27 \,\mathrm{V}$$

The emitter voltage is one diode drop less than the base voltage.

$$V_{\rm E} = V_{\rm B} - V_{\rm BE} = 2.27 \,\rm V - 0.7 \,\rm V = 1.57 \,\rm V$$

Next, find the emitter current from Ohm's law.

$$I_{\rm E} = \frac{V_{\rm E}}{R_{\rm E}} = \frac{1.57 \text{ V}}{470 \Omega} = 3.34 \text{ mA}$$

Using the approximation  $I_C \cong I_E$ ,

$$I_{\rm C} = 3.34 \, {\rm mA}$$

Now find the collector voltage.

$$V_{\rm C} = V_{\rm CC} - I_{\rm C}R_{\rm C} = 18 \text{ V} - (3.34 \text{ mA})(2.7 \text{ k}\Omega) = 8.98 \text{ V}$$

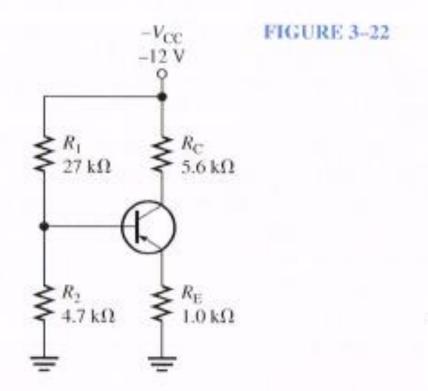
The collector-emitter voltage is

$$V_{\rm CE} = V_{\rm C} - V_{\rm E} = 8.98 \,\rm V - 1.57 \,\rm V = 7.41 \,\rm V$$

# 5-1 instelling voor transistor als versterker

# EXAMPLE 3-6

Find  $V_{\rm B}$ ,  $V_{\rm E}$ ,  $I_{\rm E}$ ,  $I_{\rm C}$ , and  $V_{\rm CE}$  for the pnp circuit in Figure 3–22.



#### SOLUTION

Begin by finding the base voltage using the voltage-divider rule.

$$V_B = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) V_{CC} = \left(\frac{4.7 \text{ k}\Omega}{27 \text{ k}\Omega + 4.7 \text{ k}\Omega}\right) (-12 \text{ V}) = -1.78 \text{ V}$$

The equation for  $V_E$  is the same one used for the npn transistor but note the signs. The emitter voltage is one diode drop greater than the base voltage for a forward-biased pnp transistor.

$$V_{\rm E} = V_{\rm B} - V_{\rm BE} = -1.78 - (-0.7 \,\rm V) = -1.08 \,\rm V$$

Now find the emitter current using Ohm's law.

$$I_{\rm E} = \frac{V_{\rm E}}{R_{\rm E}} = \frac{-1.08 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega} = -1.08 \text{ mA}$$

Using the approximation  $I_C \cong I_E$ ,

$$I_{\rm C} = -1.08 \, {\rm mA}$$

Now find the collector voltage.

$$V_{\rm C} = V_{\rm CC} - I_{\rm C}R_{\rm C} = -12 \text{ V} - (-1.08 \text{ mA})(5.6 \text{ k}\Omega) = -5.96 \text{ V}$$

The collector-emitter voltage is

$$V_{\text{CE}} = V_{\text{C}} - V_{\text{E}} = -5.96 \text{ V} - (-1.08 \text{ V}) = -4.88 \text{ V}$$

Notice that  $V_{CE}$  is negative for a pnp circuit.

# 5.2 DC-bron en AC-signalen



## Koppel- en ontkoppelcondensatoren (Coupling and Bypass Capacitors) (blz. 135)

- BJT-versterker in fig. 3-29
- AC-signaal via C1 en C3 in- en uit de versterker gebracht => C1 en C3 zijn koppelcondensatoren (laten het AC-signaal door maar blokkeert de DCspanning) (merk op dat de koppelcondensatoren in serie staan met het signaalpad)
- Condensator C2 staat parallel met R<sub>E</sub> => AC-signaal wordt kortgesloten over R<sub>E</sub>
   => C2 is een ontkoppelcondensator of bypasscondensator
  - Doel ontkoppelcondensator C2 is de versterkingsfactor te verhogen door het AC-signaal niet door R<sub>F</sub> te laten gaan.
  - Meestal kan je een ontkoppelcondensator herkennen als een van zijn aansluitklemmen verbonden is met de massa.

#### Versterking

- AC-bron V<sub>s</sub> veroorzaakt schommelingen in de basisstroom => ontstaan veel grotere schommelingen in de collector- en emitterstroom => schommelingen van het instelpunt Q
- Transistor inverteert het signaal ,dat afkomstig is van de basis, steeds aan de collector
- Versterking ontstaat doordat een een kleine verandering in basisstroom een groter variatie oplevert in de collectorspanning

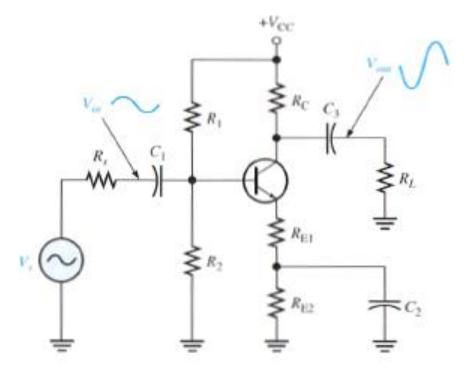


FIGURE 3-29 A basic transistor amplifier.

# Gemeenschappelijke emitterschakeling GES

ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

- Kenmerk Emitter verschijnt zowel bij ingangscircuit als outputcircuit
- Emitterklem via condensator verbonden aan massa
- Spanning over de belasting is in tegenfase met de spanning aan de ingang
- Emitterweerstand opgesplitst in twee delen  $R_{E1}$  en  $R_{E2}$  en  $R_{E2}$  is ontkoppeld
- DC-schema is spanningsdelerinstelling
- Belastingslijn:

$$I_{\text{C(sat)}} = \frac{V_{\text{CC}}}{R_{\text{C}} + R_{\text{E1}} + R_{\text{E2}}} = \frac{18 \text{ V}}{2.7 \text{ k}\Omega + 200 \Omega + 270 \Omega} = 5.68 \text{ mA}$$

$$V_{\rm B} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) V_{\rm CC} = \left(\frac{3.9 \,\mathrm{k}\Omega}{27 \,\mathrm{k}\Omega + 3.9 \,\mathrm{k}\Omega}\right) 18 \,\mathrm{V} = 2.27 \,\mathrm{V}$$

$$I_{\rm E} = \frac{V_{\rm E}}{R_{\rm E}} = \frac{1.57 \text{ V}}{470 \Omega} = 3.34 \text{ mA}$$

$$V_{\rm CE} = V_{\rm C} - V_{\rm E} = 8.98 \,\rm V - 1.57 \,\rm V = 7.41 \,\rm V$$

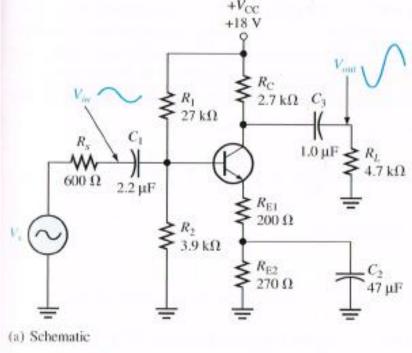
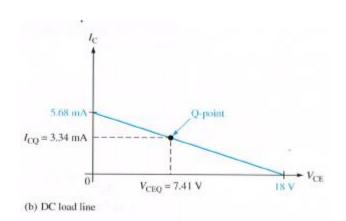


FIGURE 3-30 A basic common-emitter amplifier.



# 3-4 Gemeenschappelijke emitterschakeling GES (common-emitter CE)



## **AC Equivalent Circuit (blz. 137)**

- AC-circuit zie fig. 3-31 : capaciteiten van fig. 3-30(a) kortsluiten en DC-voeding eveneens kortsluiten (of beschouwen als massa voor ac (ac-ground)).
- R<sub>E2</sub> verdwijnt uit de schakeling vermits deze is kortgesloten door C<sub>2</sub>.
- Interne weerstand in transistor weergegeven tussen B en E =>  $r'_e$ . Dit is de dynamische emitterweerstand en als volgt te vinden:

$$r'_e = \frac{25 \text{ mV}}{I_E}$$

## EXAMPLE 3-9

Find the dynamic emitter resistance,  $r'_e$ , for the circuit in Figure 3–30(a).

#### SOLUTION

The emitter current was found to be 3.34 mA (see Example 3–5). Substituting into Equation (3–9),

$$r'_e = \frac{25 \text{ mV}}{I_E} = \frac{25 \text{ mV}}{3.34 \text{ mA}} = 7.5 \Omega$$

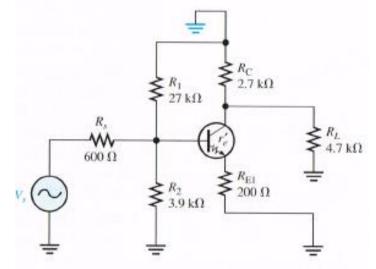


FIGURE 3-31 AC equivalent circuit for Figure 3-30(a).

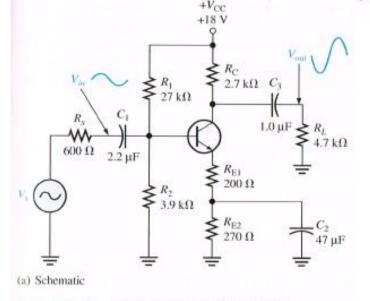


FIGURE 3-30 A basic common-emitter amplifier.

# 3-4 Gemeenschappelijke emitterschakeling GES (common-emitter CE)



# EXAMPLE 3-10

Find  $A_{\nu}$  for the circuit in Figure 3–30(a).

## SOLUTION

The ac resistance in the emitter circuit,  $R_e$  is composed of  $r'_e$  in series with the unbypassed  $R_{E1}$ . From Example 3–9,  $r'_e = 7.5 \Omega$ . Therefore,

$$R_e = r'_e + R_{E1} = 7.5 \Omega + 200 \Omega = 207.5 \Omega$$

Next, find the ac resistance as viewed from the transistor's collector.

$$R_c = R_C || R_L = 2.7 \,\mathrm{k}\Omega \,|| 4.7 \,\mathrm{k}\Omega = 1.71 \,\mathrm{k}\Omega$$

Substituting into Equation (3–10),

$$A_v \simeq -\frac{R_c}{R_e} = -\frac{1.71 \text{ k}\Omega}{207.5 \Omega} = -8.3$$

Again, the negative sign is used to show that the amplifier inverts the signal.

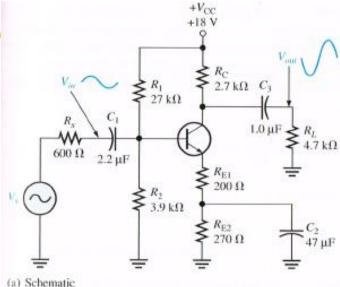


FIGURE 3-30 A basic common-emitter amplifier.

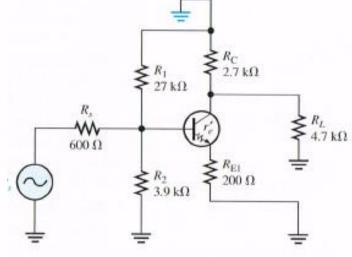


FIGURE 3-31 AC equivalent circuit for Figure 3-30(a).

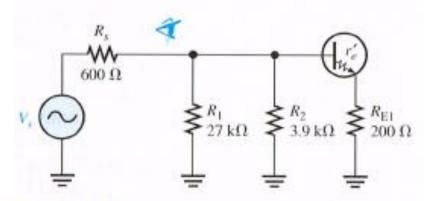
# 3-4 Gemeenschappelijke emitterschakeling GES



## Ingangsweerstand

R<sub>in(tot)</sub> is de ingangsweerstand van de totale versterker (CE)

$$R_{in(tot)} = R_1 ||R_2|| [\beta_{ac}(r'_e + R_{E1})]$$



#### IGURE 3-32 Equivalent ac input circuit for the E amplifier in Figure 3-30(a).

# EXAMPLE 3-11

Find  $R_{in(tot)}$  for the circuit in Figure 3–30(a). Assume the  $\beta_{ac}$  is 120.

#### SOLUTION

The internal ac emitter resistance,  $r'_e$ , was found to be 7.5  $\Omega$  in Example 3–9. Substituting into Equation (3–11),

$$R_{in(tot)} = R_1 \| R_2 \| [\beta_{ac}(r'_e + R_{E1})]$$
  
= 27 k\Omega \| 3.9 k\Omega \| [120 (7.5 \Omega + 200 \Omega)] = **3.0** k\Omega

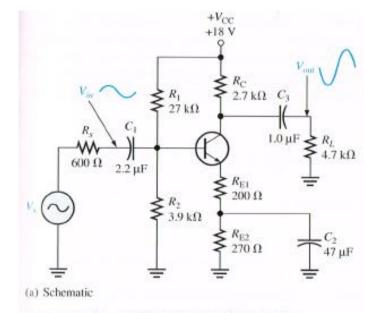


FIGURE 3-30 A basic common-emitter amplifier.

# 3-4 Gemeenschappelijke emitterschakeling GES (common-emitter CE)

## **Uitgangsweerstand**

• Is gelijk aan de collectorweerstand R<sub>c</sub> (als interne weerstand stroombron oneindig mag worden beschouwd)

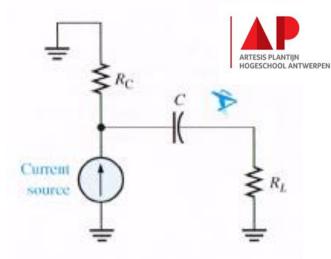


FIGURE 3-33 Equivalent ac output circuit for the CE amplifier.

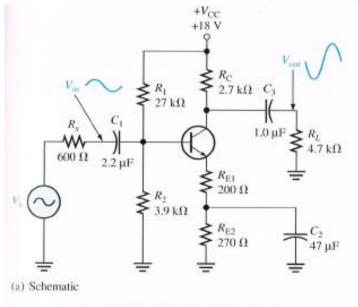


FIGURE 3-30 A basic common-emitter amplifier.

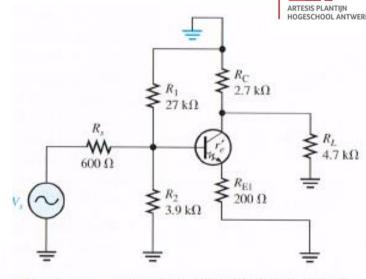
# 3-4 Gemeenschappelijke emitterschakeling GES

## AC belastingslijn (loadline)

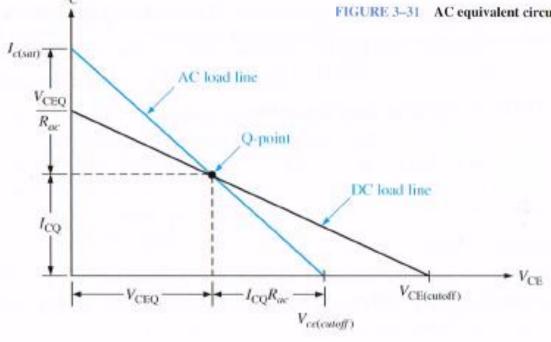
$$I_{c(sat)} = I_{CQ} + \frac{V_{CEQ}}{R_{ac}}$$

$$V_{ce(cutoff)} = V_{CEQ} + I_{CQ}R_{ac}$$

$$R_{ac} = r'_e + R_{E1} + (R_C || R_L)$$



AC equivalent circuit for Figure 3-30(a).



The dc and ac load lines. FIGBURE 3-34

#### EXAMPLE 3-12

Draw the ac load line for the circuit in Figure 3-30(a).

#### SOLUTION

The dc load line for this circuit was shown in Figure 3–30(b) and is shown in Figure 3–35 for reference. The Q-point coordinates are  $V_{\rm CEQ}=7.41~{\rm V}$  and  $I_{\rm CQ}=3.34~{\rm mA}$ .

Before locating the ac load line, it is necessary to find the ac resistance of the collector-emitter circuit. As you know, the emitter circuit has  $r'_e + R_{\rm EI}$  in series. The collector circuit has the parallel combination of  $R_{\rm C} \parallel R_L$ . The total ac resistance of the collector-emitter circuit is

$$R_{ac} = r'_e + R_{E1} + (R_C || R_L)$$

In Example 3–9,  $r'_e$  was found to be 7.5  $\Omega$ . Substituting this value and the other fixed resistors into the previous equation results in

$$R_{ac} = 7.5 \Omega + 200 \Omega + (2.7 k\Omega | 4.7 k\Omega) = 1.92 k\Omega$$

Now, find the ac collector saturation current.

$$I_{c(sat)} = I_{CQ} + \frac{V_{CEQ}}{R_{ac}} = 3.34 \text{ mA} + \frac{7.41 \text{ V}}{1.92 \text{ k}\Omega} = 7.20 \text{ mA}$$

Next, find the ac collector-emitter cutoff voltage.

$$V_{ce(cutoff)} = V_{CEQ} + I_{CQ}R_{ac} = 7.41 \text{ V} + (3.34 \text{ mA})(1.92 \text{ k}\Omega) = 13.8 \text{ V}$$

Together, the ac collector saturation current, the Q-point, and the ac collectoremitter cutoff voltage establish a straight line. The ac load line can now be drawn and is shown in Figure 3–35.

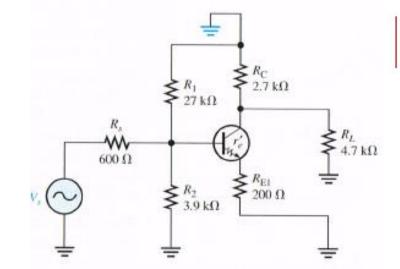


FIGURE 3-31 AC equivalent circuit for Figure 3-30(a).

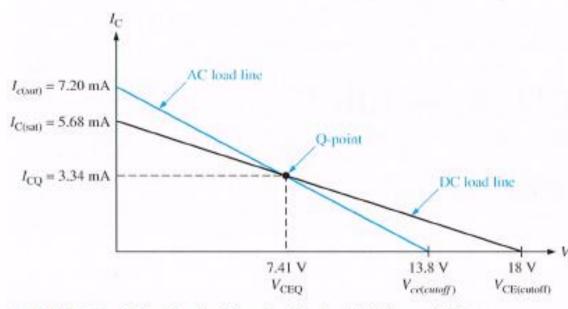


FIGURE 3-35 DC and ac load lines for the circuit in Figure 3-30(a).

# 3-4 Gemeenschappelijke emitterschakeling GES (common-emitter CE



## **Section 3-4 CHECKUP**

- 1. Welke aansluiting (E,B of C) van een GES versterker is de ingangspen? En welke is de uitgangspen?
- 2. Wat is het voordeel van een versterker met een hoge ingangsweerstand?
- 3. Hoe wordt de (spannings)versterking bepaalt in een GES versterker?



BJTs 13

# 3-5 Gemeenschappelijke collectorschakeling GCS



Collector direct met de voeding verbonden Ingang is de basis en uitgang is de emitter

## **Spanningsversterking (Voltage Gain)**

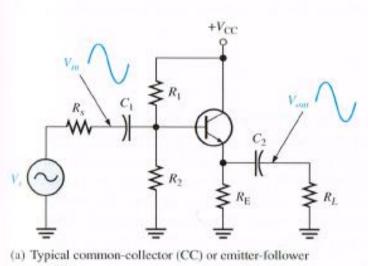
Ingangsspanning staat over r'<sub>e</sub> + parallelschakeling R<sub>E</sub> met R<sub>L</sub> Uitgangsspanning staat over parallelschakeling R<sub>F</sub> met R<sub>I</sub>

$$A_{\nu} \cong 1$$

## Ingansweerstand (input resistance) (blz. 144)

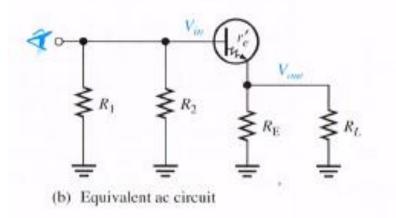
$$R_{in(tot)} = R_1 ||R_2|| [\beta_{ac}(r'_e + R_E ||R_L)]$$
(3–13)

BJT



amplifier

#### FIGURE 3-37



14

# 3-5 Gemeenschappelijke collectorschakeling GCS



## **Uitgangsweerstand (output resistance)**

Fig 3-39 toont equivalent AC-output circuit van CC-versterker

R<sub>base</sub> is de vervangingsweerstand van de bron en de instelweerstanden aan de basis (bias resistors)

Voor algemene analyses is de uitgangsweerstand ongeveer gelijk aan r'e

## Stroomversterking (current gain) (blz. 144)

$$A_{i} = \frac{I_{load}}{I_{s}} = \frac{V_{in}/R_{L}}{V_{in}/R_{in(tot)}}$$
 
$$A_{i} = \frac{R_{in(tot)}}{R_{L}}$$

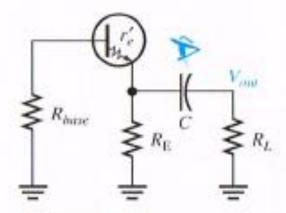
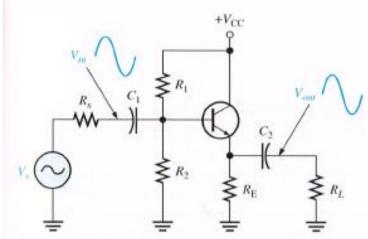


FIGURE 3-39 Equivalent ac output circuit for the CC amplifier.



 (a) Typical common-collector (CC) or emitter-follower amplifier

FIGURE 3-37

#### EXAMPLE 3-13

Determine the total input resistance,  $R_{in(tot)}$ , and the approximate voltage gain and current gain to the load of the emitter-follower in Figure 3–40. Assume the  $\beta_{ac}$  is 140.

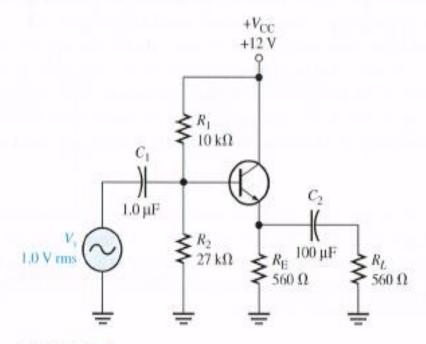


FIGURE 3-40

#### SOLUTION

Although  $r'_e$  can be ignored for the calculation of the total input resistance, it is useful to review the method for finding  $r'_e$ . The value of  $r'_e$  is determined from  $I_E$ , so the first step is to find the dc conditions. The base voltage is found from the voltage-divider rule.

$$V_{\rm B} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) V_{\rm CC} = \left(\frac{27 \,\mathrm{k}\Omega}{10 \,\mathrm{k}\Omega + 27 \,\mathrm{k}\Omega}\right) 12 \,\mathrm{V} = 8.76 \,\mathrm{V}$$

The emitter voltage is approximately  $V_{\rm B} - V_{\rm BE} = 8.06$  V. The emitter current is found from Ohm's law.

$$I_{\rm E} = \frac{V_E}{R_{\rm E}} = \frac{8.06 \text{ V}}{560 \Omega} = 14.4 \text{ mA}$$

The value of  $r'_e$  is

$$r'_{e} = \frac{25 \text{ mV}}{I_{E}} = \frac{25 \text{ mV}}{14.4 \text{ mA}} = 1.7 \Omega$$

Since this value is small compared to the emitter and load resistors, it can be ignored.

The total input resistance is

$$R_{in(tot)} = R_1 \| R_2 \| [\beta_{ac}(R_E \| R_L)]$$
  
= 10 k\O \| 27 k\O \| [140(560 \Omega \| 560 \Omega)] = **6.15 k\Omega**

Neglecting  $r'_e$ , the voltage gain is

$$A_{\nu} = 1$$

The current gain (to the load resistor) is

$$A_i = \frac{R_{in(tot)}}{R_L} = \frac{6.15 \text{ k}\Omega}{560 \Omega} = 11$$

# 3-5 Gemeenschappelijke collectorschakeling GCS



## **Darlington Pair (blz 143)**

Reden gebruik gemeenschappelijke collectorschakeling of common collector is dat deze een zeer hoge ingangsimpedantie heeft Ingangsimpedantie afhankelijk van waarde  $\beta_{ac}$  Mogelijkheid om  $\beta_{ac}$  groter te maken is gebruik maken van Darlington Pair (fig. 3-41)

$$\beta_{ac} = \beta_{ac1} \beta_{ac2}$$
 (3-13)

Grote voordeel van darlington is dat deze een zeer hoge ingangsimpedantie heeft en een zeer hoge stroomversterking.

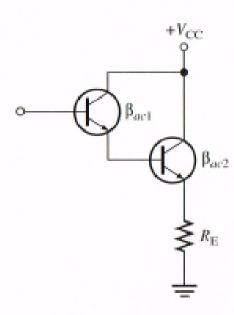


FIGURE 3-41 Darlington pair.

# 3-5 Gemeenschappelijke collectorschakeling GCS



## **Section 3-5 CHECKUP**

- 1. Wat is een andere benaming voor GCS
- 2. Wat is de ideale maximale spanningsversterking van een GCS versterker?
- 3. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een GCS?
- 4. Welk voordeel heeft een Darlington-paar transistoren op een gewone transistor?



BJTs 18

# ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

## Transconductantie (steilheid) van FET's (blz. 205)

- Transconductantie of steilheid  $g_m$  ( $y_{fs}$  in europese databoeken) is de verhouding van de drainstroomverandering op de  $V_{gs}$ -verandering
- $y_{fs} = g_m = \frac{I_d}{V_{gs}}$  (eenheid is Siemens soms ook als mho (ohm achterwaarts) aangeduid)
- Merk op dat  $y_{fs}$  de richtingscoëfficiënt is van de transferkarakteristiek en dus niet constant is. De steilheid  $y_{fs}$  is dus afhankelijk van de instelstroom  $I_D$ .
- $y_{fs}$  komt overeen met  $1/r'_e$  bij transistoren en stelt dus het omgekeerde voor van de AC-source-weerstand  $r'_s$  van de FET
- Voorbeeld als  $g_m = y_{fs}$  (in databoeken) = 2000  $\mu$ S, dan is  $r'_s$  gelijk aan 500  $\Omega$

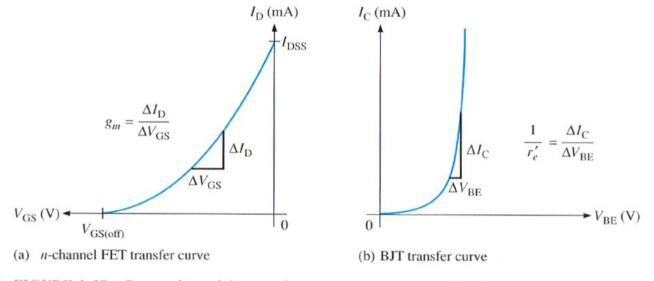


FIGURE 4–37 Comparison of the transfer curve for an *n*-channel FET with a BJT.

FETs 19

# **Gemeenschappelijke Source Schakeling (GCS)**

# Fig. 4-39 toont een GSS met N-kanaal JFET ingesteld volgens de zelfinstellingsmethode

- R<sub>G</sub> heeft twee functies: De gate instellen op ongeveer 0 V gelijkspanning (bias) en zijn grote weerstand zorgt ervoor dat de ingangsimpedantie zeer hoog is en de schakeling bijgevolg geen belasting vormt op de AC-bron.
- Instelspanning wordt gevormd door de spanningsval over R<sub>s</sub>.
- Door het aanleggen van de wisselspanning zal de bij stijging van de ingangsspanning de drainstroom stijgen waardoor V<sub>RD</sub> stijgt en bijgevolg V<sub>DS</sub> zal dalen => 180° faseverschuiving

#### Fig. 4-40 toont een zero-biased N-kanaal D-MOSFET

- $V_G$  is ongeveer  $0V \Rightarrow V_{GS} = 0V$
- V<sub>gs</sub> (afkomstig van de bron) zorgt ervoor dat het werkpunt varieert rond het 0V niveau en zorgt zo dus voor een verandering in I<sub>d</sub>.

## Fig. 4-41 toont een zero-biased N-kanaal E-MOSFET

- $V_G$  is ingesteld met spanningsdelermethode op een bepaalde positieve spanningswaarde zodat  $V_G > V_{GS(th)}$
- Een verandering van  $V_{gs}$  zorgt ook hier voor een verandering van  $I_{d}$  rond het werkpunt.

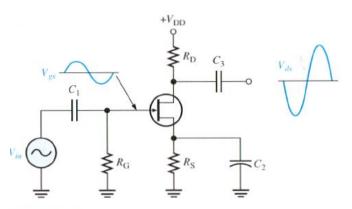


FIGURE 4-39 JFET common-source amplifier.

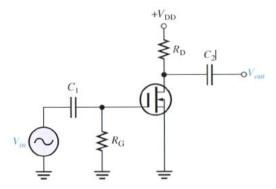


FIGURE 4-40 Zero-biased D-MOSFET commonsource amplifier.

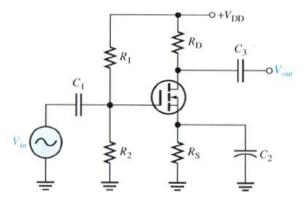


FIGURE 4-41 Common-source E-MOSFET amplifier with voltage-divider bias.



# ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

## **Gemeenschappelijke Source Schakeling**

## **Spanningsversterking**

$$A_{v} = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{I_{d}R_{d}}{V_{gs}}$$

• Vermits  $y_{fs} = I_d / V_{gs}$  is de spanningsversterking van de GSS gelijk aan :

$$A_u = -y_{fs}R_d \quad (4-7)$$

• Als  $g_m$  vervangen wordt door  $1/r'_s$  bekomen we:

$$A_{v} = -\frac{R_{d}}{r_{s}'}$$

• Vergelijk met transistor (GES) waarbij  $A_v = -R_c/R_e$ 

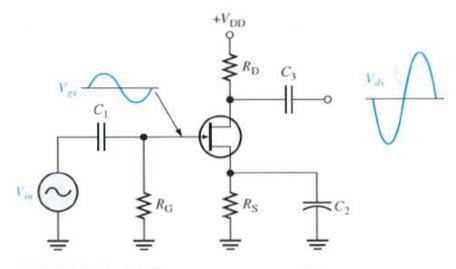


FIGURE 4-39 JFET common-source amplifier.

FETs 21

# ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

## **Gemeenschappelijke Source Schakeling**

#### ingangsweerstand

- Ingang van GSS (GS) is aan de gate => hoge ingangsimpedantie van de
   FET => kan beschouwd worden als een open keten
- Hierdoor is de totale ingangsweerstand van de schakeling gelijk aan de weerstandswaarde van de weerstand(en) aan de gate.
- Bij zelfinstelling (fig. 4-42 (a) is dit R<sub>G</sub> en bij de spanningsdelerinstelling (fig. 4-42 (b) is dit de parallelschakeling van R1 met R2

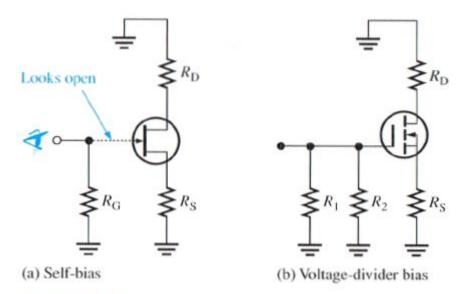


FIGURE 4-42 Input resistance is determined by the bias resistors.

FETs 22

# - EXAMPLE 4-11

- (a) Wat is de DC-drainspanning an de AC-uitgangsspannning van de versterker in figuur 4-43?  $y_{fs}=1500~\mu S$ ;  $I_D=2~mA~en~U_{GS(off)}=3~V$
- (b) Wat is de ingangsweerstand gezien vanaf de signaalbron?

#### SOLUTION

(a) First, find the dc drain voltage.

$$V_{\rm D} = V_{\rm DD} - I_{\rm D}R_{\rm D} = 15 \text{ V} - (2 \text{ mA})(3.3 \text{ k}\Omega) = 8.4 \text{ V}$$

Next, find the voltage gain.

$$A_u = -y_{fS}R_D = -(1500 \,\mu\text{S})(3.3 \,\text{k}\Omega) = -5.0$$

Alternatively, the voltage gain could be found by computing  $r'_s$  and using the ratio of ac drain resistance to ac source resistance.

$$r_s' = \frac{1}{g_m} = \frac{1}{1500 \,\mu\text{S}} = 667 \,\Omega$$

$$A_{\nu} = -\frac{R_d}{r_s'} = -\frac{3.3 \text{ k}\Omega}{667 \Omega} = -5.0$$

The ac output voltage is the gain times the input voltage.

$$V_{out} = A_v V_{in} = (-5.0)(100 \text{ mV}) = -0.5 \text{ V rms}$$

The negative sign indicates the output waveform is inverted.

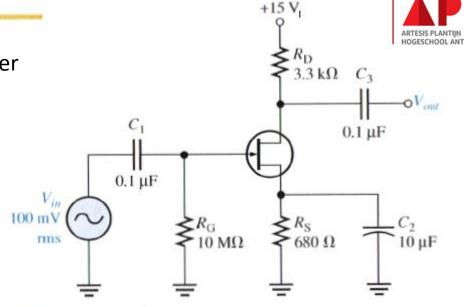


FIGURE 4-43

**(b)** The input resistance is

$$R_{in} \cong R_{\rm G} = 10 \,{
m M}\Omega$$

# **Gemeenschappelijke Drain Schakeling (GDS)**

#### Fig 4-44 toont een GDS met zelfinstelling

#### **Spanningsversterking**

• Schema is vereenvoudigd weergegeven in fig 4-45(b)

$$V_{out} = V_{in} \left( \frac{R_s}{r_s' + R_s} \right)$$

• Waardoor:  $A_{\nu} = \frac{R_s}{r_s' + R_s}$ 

• Vermits  $g_m = 1/r'_s$  bekomen we:

$$A_u = \frac{y_{fS} R_S}{1 + y_{fS} R_S} \tag{4-10}$$

## ingangsweerstand

 Dezelfde weerstand als bij GSS (dus de vervangingsweerstandswaarde van de weerstanden aangesloten aan de gate)

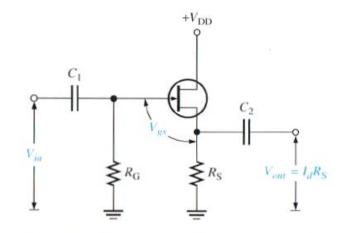
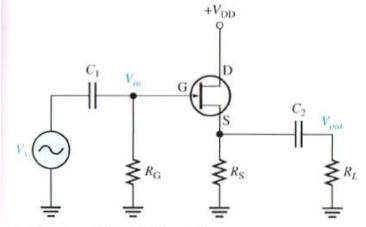


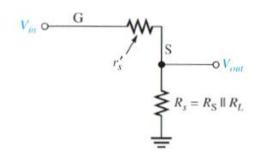


FIGURE 4–44 JFET common-drain amplifier (source-follower).



(a) A basic self-biased CD amplifier

FIGURE 4-45



(b) Simplified ac circuit to compute gain

FETs 24

# Gemeenschappelijke Drain Schakeling met stroombroninstelling (blz. 209)

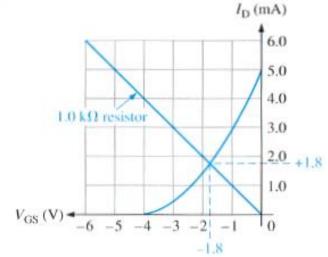
#### - EXAMPLE 4-13

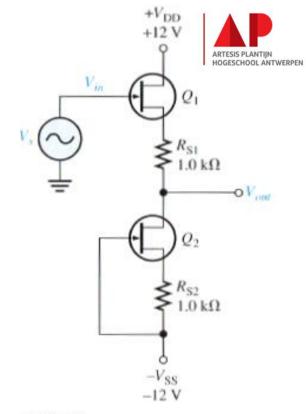
Determine the drain current,  $I_D$ , and the source voltage,  $V_S$ , of  $Q_1$  for the CD amplifier with current-source bias shown in Figure 4–48(a). Assume the FETs are matched and each has a transconductance curve as shown in Figure 4–48(b).

#### SOLUTION

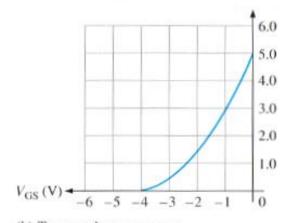
On the transconductance curve draw a line representing the 1.0 k $\Omega$  bias resistor for the current source ( $Q_2$ ). This is shown in Figure 4–49. The crossing point indicates that  $I_D$  is approximately 1.8 mA at  $V_{GS}$  of –1.8 V. This current in  $R_{S1}$  causes the source of  $Q_1$  to be at +1.8 V.







#### (a) Circuit



(b) Transconductance curve

# **Gemeenschappelijke Gate Schakeling (GGS)**

#### Fig 4-50 toont een GGS met zelfinstelling

## **Spanningsversterking**

• A<sub>v</sub> is dezelfde als bij GSS (CS)

$$A_v = \frac{R_d}{r_s'}$$
 of  $A_u = y_{fs}Rds$ 

#### ingangsweerstand

•  $R_S$  staat parallel met de inwendige sourceweerstand  $r'_s$ . Meestal is  $R_S$  van die grootte dat deze verwaarloosbaar is zodat :

$$R_{in} \cong r'_s$$
 of  $R_{in} \cong 1/y_{fs}$ 

GGS heeft een lage ingangsimpedantie

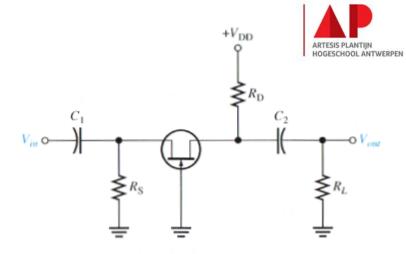


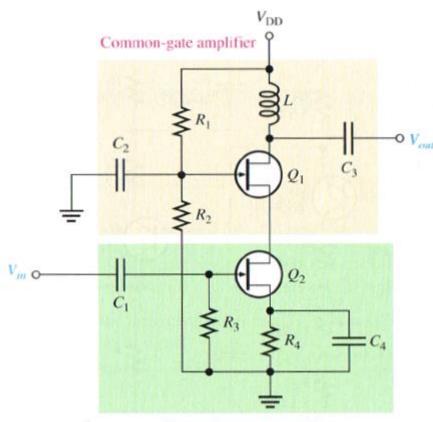
FIGURE 4-50 JFET common-gate amplifier.

FETs 26



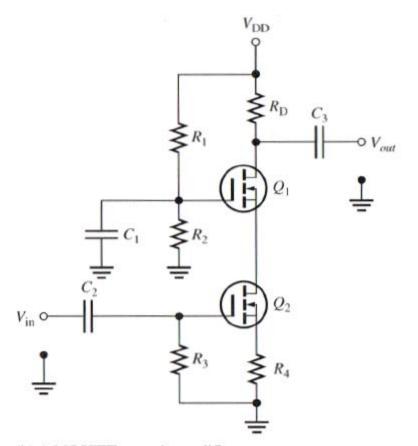
#### **Voorbeeld toepassing GGS: cascadeschakeling GGS en GSS in serie**

Worden toegepast in RF-applicaties



Common-source amplifier

(a) A JFET cascode amplifier



(b) A MOSFET cascode amplifier

#### GGS

$$A_v = rac{R_d}{r_s'}$$
 of  $A_v = g_m R_d$ 

$$R_{in} \cong r_s'$$
 of  $R_{in} \cong rac{1}{g_m}$ 

## GSS

$$A_v = -\frac{R_d}{r_s'}$$